

5回路入りNPNトランジスタアレイ

優れたペアリング特性をもつNPNトランジスタアレイ！

開発中

ESリリース中

RT8H074V

□概要

RT8H074Vは、NPNトランジスタにより構成されたトランジスタアレイです。同一チップ内に配置した素子を使用する為、ペアリング特性に優れております。

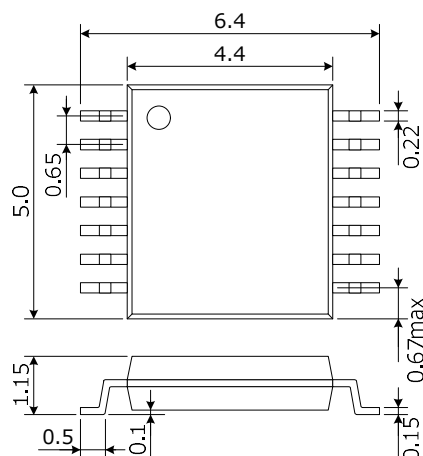
□特長

- セットの小型化、高密度実装が可能
- 優れたペアリング特性

□用途

- 温度補償付きアンチログ回路
- 温度調整回路
- カレントミラー回路
- 差動回路

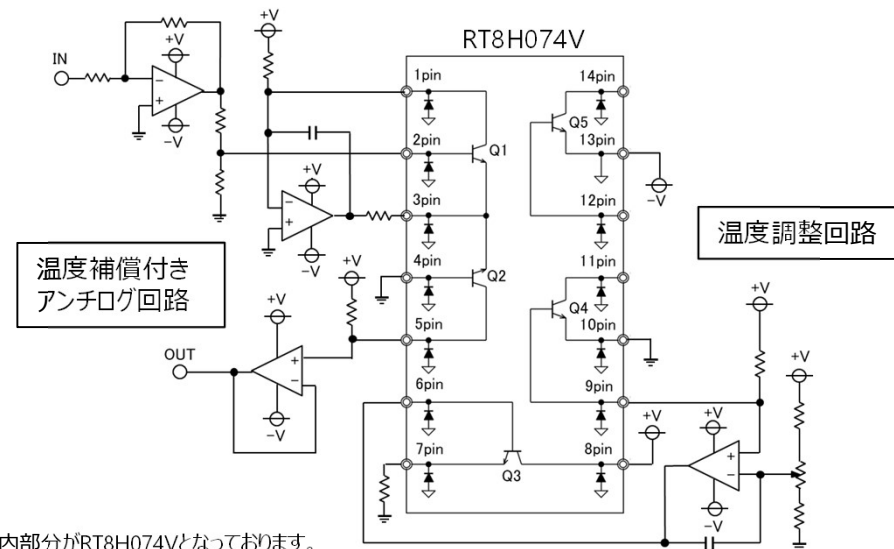
□外形・ピン配置図（単位：mm）



《ピン配置》

- | | |
|------------|------------|
| 1. Q1コレクタ | 14. Q5コレクタ |
| 2. Q1ベース | 13. Q5エミッタ |
| 3. Q12エミッタ | 12. Q5ベース |
| 4. Q2ベース | 11. Q4コレクタ |
| 5. Q2コレクタ | 10. Q4エミッタ |
| 6. Q3ベース | 9. Q4ベース |
| 7. Q3エミッタ | 8. Q3コレクタ |

□内部ブロック図、応用回路例(アンチログ回路)



※枠内部分がRT8H074Vとなっております。

※Q3は他トランジスタと比較して100倍の電流能力を有しており、本回路では発熱用として使用しております。

□電気的特性(指定が無い場合は、Ta=25℃)

記 号	項 目	条 件	規 格 値			単 位
			最小	標準	最大	
VBE	VBEペアリング特性	Q1,Q2 : CBショート IE=100uA VBE1-VBE2	-1	0.1	1	mV
IMIRROR	ミラー電流	B1B2ショート C1=100uA VCE2=0.7V C1電流-C2電流	-2	0	2	uA
$\Delta VBE/\Delta T$	VBE温度依存性		-	-1.9	-	mV/℃
ICBO	コレクタカットオフ電流	VCB=10V、IE=0	-	-	0.2	uA
hFE	直流電流増幅率	VCE=6V、IB=5uA	100	300	600	-
VBE	BE間電圧	CBショート、IE=100uA	500	-	800	mV
VSAT	出力飽和電圧	Q1,Q2 : IB=400uA IC=4mA	0	-	400	mV
		Q3 : IB=2mA IC=20mA				
		Q4,Q5 : IB=100uA IC=1mA				